

ВОПРОСЫ

для поступления в магистратуру
по направлению - «Электроника и нанoeлектроника»

1. Квантовая и оптическая электроника

1. Атом водорода. Квантовые числа. Энергетические состояния атомов.
2. Квантовые переходы. Вероятность перехода. Матричный элемент.
3. Спонтанное и индуцированное излучение. Коэффициенты Эйнштейна.
4. Принцип работы лазеров и мазеров. Инверсия населенностей.
5. Кинетические уравнения. Методы возбуждения активного вещества.
6. Оптические резонаторы. Добротность и потери в резонаторах.
7. Собственные типы колебаний. Типы резонаторов. Селекция мод.
8. Нестационарная генерация. Модуляция добротности резонатора.
9. Гигантские импульсы. Синхронизация мод и сверхкороткие лазерные импульсы.
10. Нелинейная поляризуемость кристалла и нелинейные оптические эффекты.
11. Генерация второй гармоники. Условие фазового синхронизма.
12. Люминесценция полупроводников. Квазиуровни Ферми, механизмы излучательной релаксации.
13. Общая характеристика газовых лазеров. Гелий – неоновый лазер.
14. Общая характеристика лазеров на твердом теле. Рубиновый и неодимовый лазеры.
15. Полупроводниковые лазеры.

2. Оптоэлектроника, вакуумная и плазменная электроника

1. Фоторезисторы. Принцип работы, схемы, основные характеристики.
2. Фотодиоды. Режимы работы, основные характеристики, схемы, включения.
3. Взрывная эмиссия.
4. Тонкие электронные линзы.
5. Частота собственных колебаний плазмы.

3. Твердотельная электроника

1. Эффективная масса носителей заряда. Изоэнергетические поверхности.
2. Примесные состояния полупроводников. Мелкие и глубокие примеси.

3. Плотность квантовых состояний в зонах. Концентрация электронов и дырок в зонах. Собственный полупроводник.
4. Электропроводность полупроводников. Зависимость проводимости от температуры.
5. Эффект Холла в полупроводниках. Магнетосопротивление.
6. Диффузия и дрейф неравновесных неосновных носителей в полупроводниках.
7. Контакт металл – полупроводник. Контактная разность потенциалов. Шоттки диод.
8. Контакт электронного и дырочного полупроводников (р – n переход). Диодная теория выпрямления.
9. Принцип биполярного транзистора, его параметры и выходные характеристики.
10. Принцип работы полевого транзистора, его параметры и выходные характеристик.

4. Микроэлектроника, физические основы электроники СВЧ, материалы и элементы электронной техники

1. Получение металлургического и монокристаллического кремния, как исходного материала для производства полупроводниковых приборов и ИС.
2. Технологический маршрут производства биполярных полупроводниковых приборов и ИС.
3. Полупроводниковые солнечные элементы.
4. Виды поляризации волн. Докритический, критический и закритический режимы волновода. Структура основной волны Н₁₀ полого металлического волноводапрямоугольного сечения.
5. Режимы бегущей и стоячей волн в линии передачи. Коэффициент стоячей волны по напряжению.
6. Антенны как устройства избирательной передачи или приема сигналов по направленному и частотному признакам. Границы зон излучения антенн – ближней зоны, зоны Френеля и дальней зоны Фраунгофера.
7. Т – Х фазовые диаграммы равновесия двухкомпонентной системы при неограниченной растворимости компонент.
8. Необходимые и достаточные условия для неограниченной растворимости компонент твердого раствора. Описание процесса кристаллизации твердого раствора Si_{1-x}Ge_x по его Т – Х фазовой диаграмме равновесия.
9. Р – Т фазовые диаграммы равновесия. Т – Х фазовые диаграммы равновесия двухкомпонентной системы при ограниченной растворимости компонент.

10. Механизм зародышеобразования при гомогенной кристаллизации, понятие критического радиуса кристаллизации, основные методы выращивания объемных кристаллов – метод Чохральского, метод Бриджмена.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пихтин А.Н. Физические основы квантовой электроники и оптоэлектроники.- М.: “Высшая школа”, 1983.- 304 с.
2. Карлов Н.В. Лекции по квантовой электронике.- М.: “Наука”, 1988.- 336 с.
3. А. Ярив «Введение в оптическую электронику», М., Высшая школа 1989.
4. Дж. Гауэр «Оптические системы связи», М., Радиосвязь 1989.
5. С.А.Фридрихов, С.М. Мовнин, Физические основы электронной техники. М., Высшая школа, 1982г.
6. Л.А. Арцимович, С.Ю. Лукьянов, Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях, М.: Наука, 1978г.
7. Л.Н.Розанов, Вакуумная техника, М., Высшая школа, 1982г.
8. В.Е.Голант, А.П. Жилинский, С.А.Сахаров, Основы физики плазмы, М.: Атомиздат, 1977г.
9. Курс лекций по вакуумной и плазменной электронике.
10. А.И. Ансельм, “Введение в теорию полупроводников”, М.: Наука, 1978г.
11. В.Л.Бонч-Бруевич, С.Г.Калашников “Физика полупроводников” М.,Наука,1972
12. К.В.Шалимова, “Физика полупроводников”, М., 1985г.
13. С.М.Зи, “Физика полупроводниковых приборов”, т.1,2, М,Мир, 1984г.
14. С.С.Горелик, М.Я. Дашевский “Материаловедение полупроводников и диэлектриков”, М., 1988.
15. Р. Маллер, Т. Кейминс, “Элементы интегральных схем”, М., 1989.
16. И. Броудай, Дж. Меррей, “Физические основы микротехнологии”, М., 1985.
17. Н.А. Семенов, Техническая электродинамика. – М.: Изд. Связь, 1983.
18. Лебедев И.В., Техника и приборы СВЧ. – М.: Изд. ВШ. Т.2, 1972.